

	<p><b>SIR890DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR890DP-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR890DP-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 824270 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR890DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	824270 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR890DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2747pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 50A (Tc) 5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIR890DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR890DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR890DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR890DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR892DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR888DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR892DP-T1-E3</b> VISHAY SIR892DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR890DP-T1-E3</b> VISHAY SIR890DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SIR888DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR892DP</b> SI SIR892DP SI</p>	 <p><b>SIR890DP</b> SI SIR890DP SI</p>	 <p><b>SIR890DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>

### SIR890DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR890DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR890DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR890DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR890DP-T1-GE3
SIR890DP-T1-GE3 Electronic	SIR890DP-T1-GE3-Komponenten	SIR890DP-T1-GE3-Verteiler	SIR890DP-T1-GE3-Bild	SIR890DP-T1-GE3-Teil
SIR890DP-T1-GE3 Preis	SIR890DP-T1-GE3 Hersteller	SIR890DP-T1-GE3 Bild	SIR890DP-T1-GE3 Aktie	SIR890DP-T1-GE3 Inventar
SIR890DP-T1-GE3 Neu	SIR890DP-T1-GE3 Original	SIR890DP-T1-GE3 garantiert	SIR890DP-T1-GE3 RFQ	SIR890DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited